

УДК 537.312.62

©1995

## ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ СОЕДИНЕНИЙ $\text{LnBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$

Г.-Ю. Бабонас, Р. Дагис, В. Крэгжде, Г. Пукинскас,  
Л. И. Леонюк, А. Г. Веткин

Институт физики полупроводников АН Литвы, Вильнюс

(Поступила в Редакцию 24 января 1994 г.

В окончательной редакции 15 августа 1994 г.)

В области энергий 1–5 eV при 300 K измерены оптические спектры монокристаллов  $\text{LnBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  (Ln-Sm, Gd) и проведено их сравнение со спектрами иттриевых соединений типа (123). Показано, что в оптических спектрах  $\text{LnBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  могут проявляться особенности, свойственные как для обогащенных кислородом, так и для кислородно-дефицитных кристаллов типа (123). Присутствие компоненты с-поляризации для структуры при 2.8 eV и отсутствие пика при 4.1 eV совместно с ярко выраженной структурой при 1.7 eV и ее слабой поляризационной зависимостью в плоскости ab объясняются особенностями микроструктуры кристаллов  $\text{Ln}(\text{Ln}, \text{Ba})_2\text{Cu}_{3-y}\text{O}_z$ , которые в отдельных образцах могут быть различными и определяться дефицитностью Cu(1)-O прослойки, замещением позиций Ba редкоземельными ионами и позиций Cu — алюминием, а также разупорядочением кислородных вакансий.

В настоящее время известно значительное количество работ, посвященных исследованию оптических спектров Си-оксидных соединений ВТСП, проведенных в основном с целью получения непосредственной информации об электронной структуре этих материалов. Однако даже для соединений типа (123), которые исследуются в большинстве работ, однозначного ответа относительно микроскопической природы электронных возбуждений, ответственных за структуры в оптических спектрах, не существует. Одной из причин этого является, как правило, отсутствие информации о составе, кристаллической структуре и характере легирования исследуемых образцов. Изменение этих параметров может оказать существенное влияние на спектры и их интерпретацию. Представляемые в настоящей работе результаты исследования спектров монокристаллов  $\text{LnBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  (Ln-Sm, Gd) наглядно иллюстрируют возможности таких изменений.

### 1. Образцы и методика эксперимента

Монокристаллы  $\text{LnBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  (Ln-Sm, Gd) были синтезированы в алундовых тиглях из расплава состава  $3\text{Ln}_2\text{O}_3 - 25\text{BaCO}_3 - 72\text{CuO}$  при его охлаждении от 1150 до 700 °C с переменной скоростью 1–5 deg/h.

Состав кристаллов определяется методом микрорентгеновского структурного анализа. В исследуемых образцах обнаружено присутствие Al. Средний состав образцов Sm- и Cd-соединений был равен

$\text{Sm}_{1.14}\text{Ba}_{1.72}\text{Cu}_{2.45}\text{Al}_{0.45}\text{O}_x$  и  $\text{Gd}_{1.0}\text{Ba}_{2.0}\text{Cu}_{2.76}\text{Al}_{0.19}\text{O}_x$  соответственно. Рентгеновским структурным анализом определены параметры тетрагональной элементарной ячейки, равные  $a = 3.896(4)$ ,  $c = 11.598(10)$  Å и  $a = 3.89$ ,  $c = 11.70$  Å для монокристаллов Sm- и Gd-соединений соответственно.

Структурным анализом для кристаллов Sm-соединения подтверждено вхождение самария и в позиции бария [1], что является характерным для крупных Ln катионов (Pr-Eu). В структуре типа (123) исследованные кристаллы представляются формулой  $\text{Sm}(\text{Sm}_{0.1}\text{Ba}_{0.9})_2(\text{Cu}_{0.82}\text{Al}_{0.18})_3\text{O}_z$ . В кристаллах исследованного Gd-соединения  $\text{Gd}_{1.0}\text{Ba}_{2.0}\text{Cu}_{2.76}\text{Al}_{0.19}\text{O}_x$  было установлено отклонение катионной подрешетки от стехиометрического состава с дефицитностью Cu-позиций, равной  $d_{\text{Cu}} = 1.7\%$ . Как было показано для Y-соединений типа (123) [2], величина  $d_{\text{Cu}}$  связана со сверхпроводящими свойствами Cu-оксидных соединений.

Сверхпроводящие свойства образцов были оценены по данным эффекта Мейсснера. Было установлено, что кристаллы Sm-соединения являются несверхпроводящими, а для Gd-кристаллов значение критической температуры  $T_c \approx 45$  K.

Для оптических измерений использовались монокристаллы в виде пластинок, ориентированных перпендикулярно оси  $c$ , размером  $3 \times 3 \times 0.2\text{--}0.5$  mm. Оптические измерения проводились при 300 K в области энергий 1–5 eV для двух ортогональных ориентаций образца относительно плоскости падения света с использованием спектрального фотометрического эллипсометра с врачающимся анализатором и фотопротяжим модулятором поляризации света. Компоненты диэлектрического тензора вычислялись с модели изотропный кристалл–воздух. Некоторые образцы были достаточно толстыми, что позволило провести измерения для света, поляризованного вдоль оси  $c$ . В данном случае для получения компонент диэлектрического тензора, определяемого в кристаллографической системе координат с  $z$ -осью, параллельной  $c$ -оси, диэлектрическая функция вычислялась в модели одностороннего кристалла.

Контрольные измерения проводились для монокристаллов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  типа (123).

## 2. Результаты и обсуждения

На рис. 1 приведены вещественная и мнимая части диэлектрической функции  $\epsilon$  для кристаллов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  типа (123) при  $z \approx 6$  (a) и  $z \approx 7$  (b). Эти спектры весьма близки к наблюдаемым для керамических образцов [3], монокристаллов [4,5] и тонких пленок [6], а также хорошо согласуются с данными, полученными недавно в [7,8].

В оптических спектрах кристаллов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  типа (123) в области энергий 1–5 eV обычно выделяют три группы более ярко выраженных спектральных особенностей (см. [8–10]): структуру A при энергиях 1.5–1.7 eV, B — при 2.5–2.8 eV и C — при 4.1 eV. При этом характер проявлений этих структур довольно различен для обогащенных кислородом и для дефицитных по кислороду кристаллов. Структуры A и B свойственны для обеих групп кристаллов. Однако для кислородно-дефицитных ( $z \approx 6$ ) кристаллов они ярко выражены только

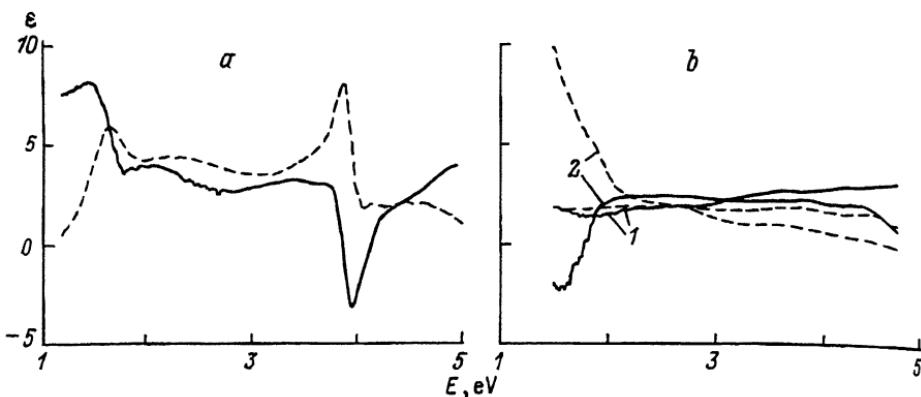


Рис. 1. Вещественная (сплошные линии) и мнимая (штриховые линии) части диэлектрической функции, вычисленные по данным эллипсометрических измерений от плоскости *ab* кристаллов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  с малой ( $z \approx 6$ ) (а) и большой ( $z \approx 7$ ) (б) концентрацией кислорода.

Спектры 1,2 (б) получены от однодоменной области образца для двух экспериментальных конфигураций с осями *a* и *b*, параллельными плоскости падения.

для а-, б-поляризаций и изотропны в плоскости *ab*. Для обогащенных кислородом кристаллов ( $z \approx 7$ ) они анизотропны в плоскости *ab* и также хорошо проявляются для с-поляризации. Интенсивность пика *C*, который поляризован в плоскости *ab*, непосредственно связана с количеством кислорода. Пик *C* наиболее интенсивен при  $z = 6$  и исчезает, когда  $z$  приближается к 7.

В измеренных оптических спектрах монокристаллов  $\text{LnBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  (рис. 2, 3) мы наблюдали отличия от стандартных спектров редкоземельных соединений типа (123) [4], так как в них проявляются черты как кислородно-дефицитных, так и обогащенных кислородом соединений. С одной стороны, в них, как и в спектрах обогащенных кислородом соединений типа (123), структуры *A* и *B* наблюдаются для с-поляризации, а пик *C* отсутствует. С другой стороны, слабая поляризационная зависимость структур *A*, *B* в плоскости *ab* и очень ярко выраженная структура *A* свойственны для соединений типа (123), дефицитных по кислороду.

Обсудим причины такой специфики спектров  $\text{LnBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_2$ , предполагая, как обычно принято и как следует из сопоставления спектров соединений типа (123) и их родственных кристаллов, что оптические особенности *A*, *B* и *C* обусловлены главным образом электронными возбуждениями в структурных единицах  $\text{Cu}-\text{O}$ . Учитывая сложности, связанные с обоснованием применимости одноэлектронных зонных расчетов для систем с незаполненными  $d^N$ -оболочками, ограничимся рассмотрением этих возбуждений в рамках простой кластерной модели.

В этой модели особенность *A* приписывается, как правило, переходу с переносом заряда  $d^9 - \bar{L}d^{10}$  ( $\bar{L}$  обозначает дырку в заполненных оболочках лигантов). В случае квадратной координации  $\text{Cu}^{2+}$  конфигурации  $d^9$  незаполненным является состояние  $x^2 - y^2$  (оси *x* и *y* направлены по диагонали квадрата), соответствующее симметрии  $B_{1g}$  группы  $D_{4h}$ . В принципе разрешенными в это состояние являются как переходы *z*-поляризации из молекуллярных орбиталей (МО) симметрии  $\bar{B}_{2u}$ , так и *x*, *y*-поляризации из МО симметрии  $E_u$ . Однако МО симметрии  $B_{2u}$  будут значительно слабее, чем из  $E_u$ . Этим объясняется характер поляризационных свойств структуры *A*, приписываемой переходу

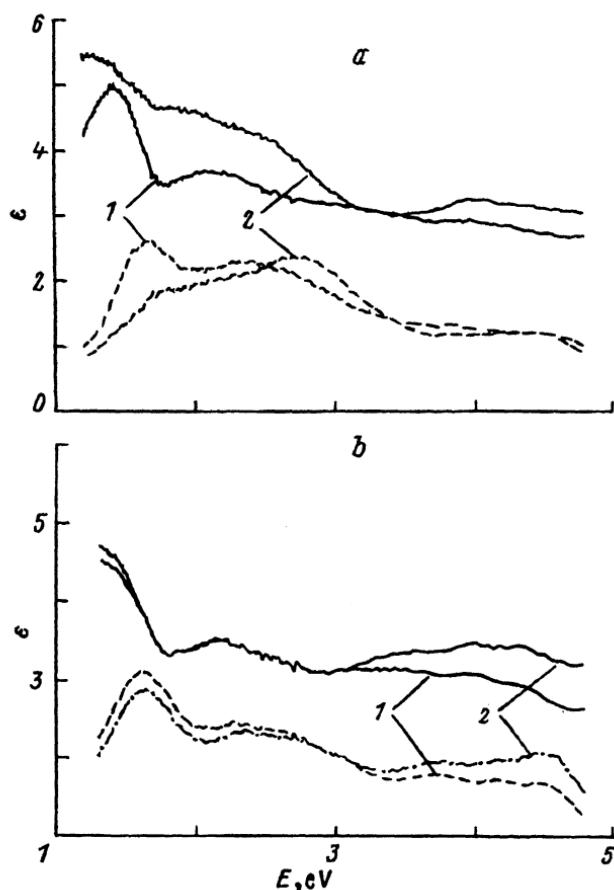


Рис. 2. Вещественная (сплошные линии) и мнимая (штриховые линии) части диэлектрической функции монокристалла  $GdBa_2Cu_{3-y}O_z$  ( $T_c \approx 45$  K), вычисленные по данным эллипсометрических измерений от плоскости  $ac$  для поляризаций света  $e \parallel a$  (1) и  $e \parallel c$  (2) (a) и от плоскости  $ab$  для двух (1,2) ортогональных ориентаций образца по отношению к плоскости падения света (b).

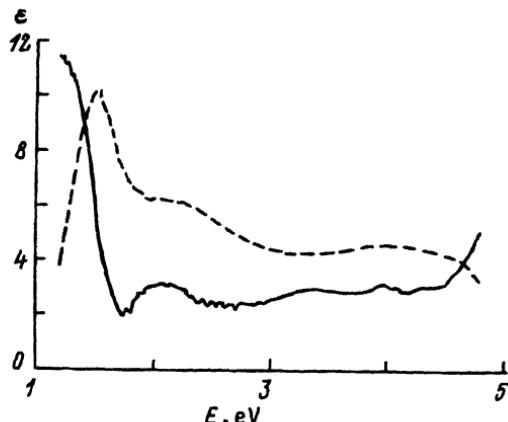


Рис. 3. Вещественная (сплошная линия) и мнимая (штриховая линия) части диэлектрической функции, вычисленные по данным эллипсометрических измерений от плоскости  $ab$  несверхпроводящего кристалла  $Sm(Sm, Ba)_2Cu_3O_z$ .

$d^9 - \bar{L}d^{10}$  в плоскости Cu(2)-O, в кислородно-дефицитных соединениях  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  ( $z \approx 6$ ).

При переходе к соединениям  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  типа (123), обогащенным кислородом ( $z \approx 7$ ), квадратное окружение иона  $\text{Cu}^{2+}$  искажается, что в общем, может привести к анизотропии структуры  $A$  в плоскости  $ab$ . Однако основной причиной сильной анизотропии, по-видимому, является наложение на переходы  $d^9 - \bar{L}d^{10}$  в  $\text{Cu}^{2+}(2)$ -O вклада от соответствующих переходов в элементе  $\text{Cu}^{2+}(1)$ -O. Если учесть, что цепочки  $\text{Cu}^{2+}(1)$ -O направлены по оси  $b$ , то переходы  $d^9 - \bar{L}d^{10}$  в  $\text{Cu}^{2+}(1)$ -O будут поляризованы в плоскости  $bc$ . Их вклад приведет к усилению структуры  $A$  в  $c$ -поляризации и появлению анизотропии в плоскости  $ab$ , т.е. структура  $A$  будет более интенсивной для  $b$ -поляризации, чем для  $a$ -поляризации. Это хорошо согласуется с экспериментальными данными, приведенными в [10], где подробно исследованы поляризационные свойства оптического спектра кристаллов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ .

Отметим, что подобные поляризационные зависимости структур  $A$  и  $B$  от количества кислорода в  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  нетрудно объяснить, если предположить, что структура  $B$  соответствует переходу  $d^9 \Rightarrow \bar{L}d^9 ns$ . Для этого перехода правила отбора подобны таковым для перехода  $d^9 - \bar{L}d^{10}$ : если плоскость квадрата совпадает с плоскостью  $ab$ , то разрешены переходы  $ab$ -поляризации из МО  $\delta$ -типа симметрии  $E_u$  и  $c$ -поляризации из МО  $\pi$ -типа симметрии  $A_{2u}$ . Следует отметить, что приписывание структуры  $B$  переходу  $d^9 \Rightarrow \bar{L}d^9 ns$  хорошо согласуется и с экспериментальными данными [11] по расположению энергетических уровней конфигураций  $3d^9 4s$  и  $3d^{10}$  в свободном ионе  $\text{Cu}^+$ . Уменьшение интервала между энергиями структур  $B$  и  $A$  в кристаллах  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  до  $\approx 1$  eV по сравнению с интервалом  $\approx 3$  eV между уровнями  $3d^9 4s$  и  $3d^{10}$  свободного иона  $\text{Cu}^+$  можно легко объяснить, учитывая расщепление  $3d^9$ -уровней в кристаллическом поле и зонное уширение  $4s$ -уровней.

Что касается пика  $C$ , то общепринято приписывать его внутриионному  $3d^{10} - 3d^9 4p$ -переходу в  $\text{Cu}^+$ . Проявление этого пика только для  $ab$ -поляризации можно объяснить, учитывая сильную гибридизацию  $4p_z$  функции с  $2p_z$ -функцией кислорода O(4) в Ba-O плоскости, которая выталкивает  $3d^9 4p_z$ -уровни в область более высоких энергий. Гибридизация  $\pi$ -типа  $4p_x$  и  $4p_y$ -функций с  $2p$  функциями O(4) является сравнительно слабой, и переходы  $3d^{10} - 3d^9 4p_{x,y}$   $ab$ -поляризации по энергиям близки к соответствующим переходам в свободном ионе. Это хорошо видно, если рассматривать кристалл в модели Слэтера нейтральных атомов и учесть расщепление  $3d^9$ -уровней в кристаллическом поле [12].

Учитывая рассмотренные модели микроскопических механизмов структур  $A$ ,  $B$  и  $C$ , нетрудно объяснить специфику их поведения в исследованных кристаллах  $\text{LnBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$ . Отсутствие в спектрах этих кристаллов структуры  $C$  указывает на то, что ионы  $\text{Cu}(1)$  находятся в состоянии  $\text{Cu}^{2+}$ , и появление  $c$ -поляризации структур  $A$  и  $B$  обусловлено соответственно  $d^9 - \bar{L}d^{10}$  и  $d^9 - \bar{L}d^9 ns$  электронными возбуждениями в элементах  $\text{Cu}^{2+}(1)$ -O. Отсутствие анизотропии структур  $A$  и  $B$  в плоскости  $ab$  можно объяснить разупорядочением элементов  $\text{Cu}^{2+}(1)$ -O(1), вызванным как дефицитностью Cu, так и наличием Al. Эти предположения хорошо подтверждаются данными структурных исследований, из которых видно, что эти кристаллы являются тетрагональными.

Следует отметить, что присутствие в исследованных кристаллах Al, который предположительно замещает Cu(1), способствует как разупорядочению структурных элементов, так и увеличению концентрации кислорода и, как следствие, увеличению координации ионов Cu в базальной плоскости и уменьшению концентрации одновалентных ионов Cu.

Структурные особенности исследованных кристаллов  $\text{Sm}(\text{Sm}, \text{Ba})_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  ответственны и за сильную интенсивность структур A и B, которая прямо пропорциональна числу бездырочных кластеров Cu-O. Можно предположить, что в  $\text{Sm}(\text{Sm}, \text{Ba})_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  это число будет сравнительно большим из-за малой вероятности образования дырок при большой концентрации ионов Al в базальной плоскости и при частичной компенсации дырок электронами избыточных атомов Ln, занимающих позиции Ba.

Учитывая сверхпроводящий характер исследованных кристаллов  $\text{GdBa}_2\text{Cu}_{3-y}\text{O}_z$ , можно предположить, что уменьшение в их спектрах интенсивностей структур A и B по сравнению с  $\text{Sm}(\text{Sm}, \text{Ba})_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  обусловлено увеличением числа дырок и относительным уменьшением бездырочных кластеров Cu-O. Следует отметить, что подобная корреляция между числом дырок и интенсивностью структур A и B наблюдалась и для  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  [13], если предположить, что  $T_c$  пропорциональна числу дырок.

В заключение отметим, что, согласно предложенной модели, отсутствие структуры C в спектрах  $\text{LnBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  просто указывает на отсутствие заметной концентрации ионов  $\text{Cu}^+$  в исследованных кристаллах. Такой вывод подтверждается структурными исследованиями  $\text{Sm}(\text{Sm}, \text{Ba})_2\text{Cu}_3\text{O}_z$  [1], которые показали отсутствие характерной для  $\text{Cu}^+$  линейной координации атомами кислорода.

#### Список литературы

- [1] Белоконева Е.Л., Леонюк Л.И., Леонюк Н.И. // СФХТ. 1991. Т. 4. № 3. С. 563–569.
- [2] Веткин А.Г., Леонюк Л.И. // СФХТ. 1993. Т. 6. № 9. С. 000–000.
- [3] Kelly M.K., Barboix P., Tarascon J.-M., Aspnes D.E., Bonner W.A., Morris P.A. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 1. P. 870–873.
- [4] Garriga M., Humlíček J., Barth J., Johnson R.L., Cardona M. // J. Opt. Soc. Am. B. 1989. V. 6. N 3. P. 470–474.
- [5] Дагис Р., Бабонас Г.-Ю., Пукинскас Г., Леонюк Л.И. // Литов. физ. сб. 1991. Т. 31. № 4. С. 343–349.
- [6] Yasuoka H., Mazaki H., Yerashima T., Bando Y. // Physica C. 1991. V. 175. N 1/2. P. 192–196.
- [7] Kotz A.L., Klein M.V., Lee W.C., Giapintzakis J., Ginsberg D.M., Veal B.W. // Phys. Rev. B. 1992. V. 45. N 5. P. 2577–2580.
- [8] Kircher J., Humlíček J., Garriga M., Cardona M., Fuchs D., Hebermeier H.-U., Jepsen O., Gopalan S., Anderson O.K. // Physica C. 1992. V. 192. N 5. P. 473–480.
- [9] Бабонас Г.-О., Дагис Р., Пукинскас Г. // Литов. физ. сб. 1992. Т. 32. № 1. С. 3–37.
- [10] Kircher J., Kelly M.K., Rashkeev S., Alouani M., Fuchs D., Cardona M. // Phys. Rev. B. 1991. V. 44. N 1. P. 217–224.
- [11] Moore Ch.E. Atomic Energy Levels. National Bureau of Standards, 1952. V. 2. 227 p.
- [12] Dagys R., Babonas G.-J. // J. Sol. State Chem. 1994. V. 109. P. 30–34.
- [13] Cooper S.L., Reznik D., Kotz A., Karlow M.A., Liu R., Klein M.V., Lee W.C., Giapintzakis J., Ginsberg D.M., Veal B.W., Paulikas A.P. // Phys. Rev. B. 1993. V. 47. N 13. P. 8233–8248.